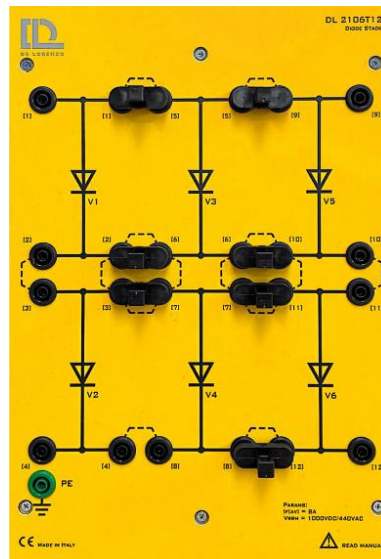


DL 2106T12



Gruppo di diodi

Sei diodi al silicio ad azione rapida con soppressore RCD, adatti per la realizzazione di circuiti raddrizzatori non-controllati.

Caratteristiche tecniche:

Corrente diretta media: $I_{F(AV)} = 8 \text{ A}$
 Tensione inversa di picco ripetitiva: $U_{RRM} = 1000 \text{ V}$
 Caduta di tensione diretta: U_F (tipica) = 1,3 V
 Tempo di recupero inverso: $t_{rr} = 47 \text{ ns max.}$

Diode stack

Six fast acting silicon diodes with RCD snubber suitable for realizing non-controlled rectifying circuits.

Technical features:

Average forward current: $I_{F(AV)} = 8 \text{ A}$
 Repetitive peak reverse voltage: $U_{RRM} = 1000 \text{ V}$
 Forward voltage drop: $U_F(\text{typ}) = 1.3 \text{ V}$
 Reverse recovery time: $t_{rr} = 47 \text{ ns max.}$

Pila de diodos

Seis diodos de silicio de acción rápida con amortiguador RCD para realizar circuitos rectificadores no controlados.

Características técnicas:

Corriente de avance media: $I_{F(AV)} = 8 \text{ A}$.
 Tensión inversa pico repetitiva: $U_{RRM} = 1000 \text{ V}$
 Caída de tensión directa: U_F (típ.) = 1.3 V.
 Tiempo de recuperación inversa: $t_{rr} = 47 \text{ ns máx}$

Pile de diodes

Six diodes au silicium à action rapide avec amortisseur RCD adaptées à la réalisation de circuits redresseurs non contrôlés.

Caractéristiques techniques:

Courant direct moyen : $I_{F(AV)} = 8 \text{ A}$
 Tension inverse crête répétitive : $U_{RRM} = 1000 \text{ V}$
 Chute de tension directe : $U_F(\text{typ}) = 1,3 \text{ V}$
 Temps de récupération inverse : $t_{rr} = 47 \text{ ns max.}$